

Supplier Search Program RFI Form

<日本語/Japanese>

<English>

会社名: ルネサス エレクトロニクス株式会社

Company: Renesas Electronics Corporation

参加目的

・半導体前工程技術の課題解決を共有し、製造設備・材料開発などで共にチャレンジ頂けるメーカーとの出会いを探すため
・技術窓口者がFace-to-Faceのミーティングで、自社のニーズと要望を直接伝え、セミコン・ジャパン出展者から効率的に新たな戦略的パートナーを探すため

Purpose

・ To find a manufacturer who understands the challenges of semiconductor wafer process technology and is willing to work with us in the development of manufacturing equipment and materials to solve these challenges.
・To enable technical contact persons to communicate their needs and requirements directly in Face-to-Face meetings and to efficiently find new strategic partners among SEMICON Japan exhibitors.

提案希望 その1

タイトル : GaN向けCMP、裏面研削技術

内容 : GaN(or GaN/Si)独自のCMPや裏面研削技術 (材料、装置)

#1 Subscription Requirements

Title : CMP and Backgrind technology for GaN

Detail : CMP and Backgrind technology (Materials and equipment) for GaN(GaN on Si).

提案希望 その2

タイトル : GaNエピ向け検査技術

内容 : GaNエピ結晶欠陥を検査する技術 (検査できる項目やスループットなど)

#2 Subscription Requirements

Title: Inspection technologies for GaN epitaxy

Detail : Technologies for inspecting crystal defects in GaN epitaxial layers (including detectable defect types and throughput).

提案希望 その3

タイトル : パワーデバイス向け裏面Si厚薄化対応技術

内容 : パワーデバイス向け裏面Si厚薄化 (50um以下) 対応可能な装置、サポート技術、ハンドリング技術など

#3 Subscription Requirements

Title : Technology for Backside Si thinning process for Power Devices

Detail : Equipment, Wafer support technology, Wafer handling technology for backside Si thinning process (less than 50um) of power devices.

提案希望 その4

タイトル : 半導体前工程製造における環境負荷を低減する技術

内容 : 省エネやPFC削減など、半導体前工程製造における環境負荷低減技術

#4 Subscription Requirements

Title : Technology to reduce environmental impact in semiconductor front-end manufacturing

Detail : For reducing the environmental impact(energy saving, PFC gas reduction, et.al) of semiconductor front-end manufacturing.

提案希望 その5

タイトル : HK/MGロジックデバイス向けCVD/ALD前駆体材料

内容:HP28nmノード以降のHK/MG材料の量産向け材料

#5 Subscription Requirements

Title : Next-Generation Deposition Materials and Process Technologies for HK/MG technology node

Detail : Searching Material for 28nm HKMG

提案希望 その6

タイトル : 応力制御材料技術

内容 : 高応力SiO₂膜CVD開発

#6 Subscription Requirements

Title : Strain control materials

Detail : High stress SiO₂ (CVD) development

提案希望 その7

タイトル : 成膜材料×AI・マテリアルズインフォマティクスによる開発期間短縮

内容 : ALD/CVD材料設計、成膜条件最適化、歩留まり予測

#7 Subscription Requirements

Title : Accelerating Development of Deposition Materials through AI and Materials Informatics

Detail : ALD/CVD material design, Optimization of Deposition recipe, Yield management.